	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
7:		Устро <del>й</del> ства		
Перв. примен.	A1	VRB4812ZP-6WR3 φ. MORNSUN	1	
	A2	GeoS-5M φ. Geostar	1	
		Преобразователи неэлектрических величин		
	BL1	TEMD5510FX01	1	
	BL2	APA3010P3BT	1	
		Конденсаторы		
Cnpab. Nº	<u>C1</u>	керам., чип 0603, NPO, 50B, 1nФ ±0.1nФ	1	
IJ	<i>C2</i>	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.1мкФ ±10%	1	
	ß	ECHU1H184GX9 ф. Panasonic (плён., чип 2416, PPS, 50B, 0.18мкФ ±2%)	1	
	<i>C</i> 4	GRM32EC81C476KE15	1	
		47mkΦ ±10%)		
	<i>C5</i>	593D476X9016C ф. Vishay (тант., чип С, 16B, 47мкФ ±10%)	1	
	С6	В41858С9477М ф. EPCOS (алюм. эл-лит, рад. 18*35мм, 100B,	1	не старше 1 года
		470мкФ ±20%, низк. имп.)		
, дата	<i>C</i> 7	А755MS108M1CAAE012 ф. КЕМЕТ (алюм. полим., рад. 10*12мм, 16B,	1	
Подп. и		1000μκΦ ±20%)		
	С8	Конденсатор К58-26 – 2,7В – 100Ф (+5020)% – ЕВАЯ.673811.006ТУ	1	
Jδn.		ф. AO «Элеконд» (ионистор, рад. 20*40мм, 2.7B, 100Ф +5020%)		
Инв. № дубл.				
MH		Микросхемы		
No	DA1	МОСЗО6ЗМ (детектор нуля)	1	
Взам. инв.	DA2	TPS561201DDC φ. Texas Instruments	1	
Вза		доп. замена TPS562201DDC ф. Texas Instruments (огр. тока 2A)		
		доп. замена TPS563201DDC ф. Texas Instruments (огр. тока 3A)	1	
дата	DA3	LP5907MFX-3.3 φ. Texas Instruments	1	
Подп. и дата	DD1	SN74LVC1G126DBV φ. Texas Instruments	1	
	Изм. Лист	ВСАД. 123456.001 ПЭЗ № докум. Подп. Дата		1 ПЭЗ
7,	Разраб. И	ванов И.И.		Лит. Лист Листов
Инв. № подл.	Проверил П	етров П.П. ВоМ Converter отладочный проект		1 5
Инв.	<del>' ' -   -</del>	озина В.Н. Перечень элементов пршков А.С.		000 "НИИ БАЦА"

	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
	DD2	SCM3725ASA φ. MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.	1	
	DD3	ECS-3225MV-250-CN φ. ECS Inc. (κβαρμ., 25MΓμ ±25ppm, -40+85°C)	1	
		Элементы разные		
	EF1	SMTSO-M2-2ET ф. PEM (стойка, SMD, M2*0.4, 2мм)	1	
	ER1	FK 244 13 D2 PAK φ. Fischer Elektronik	1	
		Устройства защитные		
	FP1	MF-MSMF014 φ. Bourns (camoboccm., чип 1812, 140mA, 60B)	1	
	FU1	0451001. ф. Littelfuse, Inc. (плавкий, чип 2410, 1A, 0.6029A <sup>2</sup> c, быстрый)	1	
	FU2	ZH242 (держатель)	1	
	FV1	В72540T0400K062 ф. TDK (варистор, чип 2220, 68В, 9Дж)	1	
	FV2	SMBJ6.5CA (супрессор, двунаправ., 6.5B, 600Bm [10/1000мкс],	1	
		корпус SMB)		
	FV3	SMBJ5.0A (супрессор, однонаправ., 5B, 600Bm [10/1000мкс],	1	
		корпус SMB)		
	FV4	GSOTO5C-E3-08 (супрессор, корпус SOT-23)	1	
и дата	FV5	CDSOT23-T24CAN ф. Bourns (супрессор, корпус SOT-23)	1	
Подп. и				
		Генераторы, источники питания		
7.	GB1	CR 1/2 AA S PCBD φ. VARTA	1	
Инв. № дубл.	GB2	BR-2325/2HAN	1	
Инв	GB3	DS1092-04-B6P ф. Connfly (держатель, CR2032)	1	
0	1	доп. замена BH-25F-1 ф. Adam Tech		
инв. №		доп. замена BS-7 ф. Memory Protection Devices		
Взам. инв.				
$\vdash$	-	Устройства сигнальные		
па	HG1	СС56–12SRWA ф. Kingbright	1	
Подп. и дата	HL1	КР-1608F3C ф. Kingbright (инфракрасный, 940нм, 150град.)	1	
Подп	HL2	КРТ-1608SURCK (красный, 645/630нм, 230мкд [20мА], 120град.)	1	
	HL3	КРА-3010CGCK (зелёный, 574/570нм, 50мкд [20мА], 120град.)	1	
одл.	HL4	КРТ-1608QBC-D (синий, 460/465нм, 100мкд [20мА], 130град.)	1	
Инв. № подл.		DCAD 422/5//	 101 =	Лист
<u>₹</u>	Изм. Лист	ВСАД. 123456. С № докум. Подп. Дата	בוו וטנ	2

	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
	HL5	КРТ-1608SYCK (жёлтый, 590нм, 150мкд [20мА], 120град.)	1	
	HL6	ХРСWHT-L1-0000-008E5 ф. Cree (белый, 4000K, CRI75, 73.9лм [350мА])	1	
	HL7	SMP6-RGB ф. Bivar (многоцветный)	1	
	HL8	KPBDA-3020SURKCGKC-PF ф. Kigbright (многоцветный, сборка)	1	
	HL9	AM23ESGW ф. Kingbright (многоцветный, сборка)	1	
		Перемычки		
	J1, J2	чип 0402	2	
	J3, J4	чип 0402	2	не устанавливать
	J5, J6	чип 0402	2	
		Реле		
	K1	RZO3-1A4-DO12 φ. TE Connectivity	1	
	K2	T9GV2L24-12 φ. TE Connectivity	1	
	К3	RT214012 φ. TE Connectivity	1	
	K4	V23105A5476A201 φ. TE Connectivity	1	
Подп. и дата		Катушки индуктивности		
Тодп. ц	L1	чип 1812, 10мкГн ±10%, 250мА	1	
	<i>L2</i>	SRU1048-470Y φ. Bourns (47ΜκΓΗ ±30%, 1.5A)	1	
Й.				
Инв. № дубл.		Резисторы		
Инв	R1	чип 0603, 10к0м ±5%	1	
6	R2	чип 0603, 47к0м ±0.5%, ±25ppm/°C		
Взам. инв. №	R3	RV0805JR-071ML φ. YAGEO (чип 0805, 400B, 10κ0m ±5%)		
Взам.	RK1	NCP18XQ102J03RB φ. Murata (чип 0603, 1κ0m ±5%)	1	
	RK2	TFPT0805L1000FV φ. Vishay (чип 0805, 1000м ±1%)	1	
סנ	RP1	3006P-1-103 ф. Bourns (10к0м ±10%, подстроечный, лин. хар-ка)		
Подп. и дата				
Подп		Устройства коммутационные		
	SA1	CHS-01TA φ. Copal Electronics Inc.	1	
эдл.	SA2	SWD-08L	1	
Инв. № подл.		DCAD 403 / E/ /	004	Nucm
NHI	Изм. Лист	ВСАД. 123456. С № докум. Подп. Дата	IUI I 	1 <i>3</i> 3

	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
	SA3	MS-22D18 (движковый)	1	
	SA4	GPTS203211B φ. CW Industries	1	
	SA5	SSSF012100	1	
	SA6	PN12SHNAO3QE φ. C&K	1	
	SB1	DTSM-61N ф. Diptronics (кнопочный)	1	
	T1	Трансформатор HX1188NL ф. Pulse	1	
		Диоды		
	VD1	BAS316 (100B, 250mA, корпус SOD-323)	1	
	VD2	BAT20JFILM (Шоттки, 23B, 1A, корпус SOD-323)	1	
	VD3	BZT52H-B13 (13B ±2%, 830мВт, корпус SOD-123F)	1	
	VD4	BB545E7904 φ. Infineon	1	
	VD5	BAT54AFILM (Шоттки, 40B, 300мA, корпус S0T-23)	1	
	VD6	BAT54CFILM (Шоттки, 40B, 300мA, корпус SOT-23)	1	
	VD7	BAT54SFILM (Шоттки, 40B, 300мA, корпус S0T-23)	1	
ı				
Подп. и дата		Тиристоры		
Подп.	VS1		1	
	VS2	TYN412RG φ. ST Microelectronics (400B, 12A, 15mA)	1	
7.	VS3	ТММDB3TG ф. ST Microelectronics (двунаправ., 32B, 2A, 15мкА)	1	
Инв. № дубл.	VS4	BTA24-600BWRG	1	
Инв				
o		Транзисторы		
Взам. инв. №	VT1	ВСR108 (биполярный цифровой)	1	
Взам.	VT2	IRLML2030	1	
	VT3	BC817	1	
па	VT4	ВСR158 (биполярный цифровой)	1	
Подп. и дата	VT5	IRLML5103	1	
Подг	VT6	BC807	1	
лоди.	VU1	Onmonapa LTV-357T	1	
Инв. № подл.		BCAD.123456		7ucm
Ž	Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата	J.UUI II <u>.</u>	) J

Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
	Cooduumani		
	Соединители	1	
X1	15EDGRC-3.5-04P φ. Degson	1	
X2	5035000993 φ. Molex	1	
	доп. замена 5035000991	+	
X3	292303-1 φ. TE Connectivity	1	
	Фильтры		
ZC1	WCM4532F2SF-142T2O-HI φ. TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd.	1	
	(синф. дроссель, 1.4кОм [100МГц], 100мОм, 2А)		
ZF1	MMZ1608B102C φ. TDK (φep. δyc., чип 0603, 1κ0м ±25% [100MΓц],	1	
	600m0m, 300mA)		
ZQ1	FY0800018 ф. Diodes Incorporated (кварц., 8МГц ±30ррт, фунд., 18пФ,	1	
	1000м, -40+85°С)		
ZQ2	ABS07-32.768KHZ-T φ. Abracon (κβαρμ., 32.768κΓμ ±20ppm, 12.5nΦ,	1	
	70к0м, -40+85°С/		
		+ +	
		+ +	
		+	
		+	
		004 75	
Изм. Лист	ВСАД. 123456. U № докум. Подп. Дата	שני 101 אני	3 F

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.